

DERWENT-ACC-NO: 2001-302765

DERWENT-WEEK: 200132

COPYRIGHT 2005 DERWENT INFORMATION LTD

TITLE: Semiconductor laser module for optical communication,
mounts lens holder with lens optical system on welding
metal base made of similar material as that of welding
metal with same thermal expansion co-efficient

PATENT-ASSIGNEE: NEC CORP[NIDE]

PRIORITY-DATA: 1999JP-0077091 (March 23, 1999)

PATENT-FAMILY:

PUB-NO	PUB-DATE	LANGUAGE	PAGES	MAIN-IPC
JP 2000277843 A	October 6, 2000	N/A	009	H01S 005/022

APPLICATION-DATA:

PUB-NO	APPL-DESCRIPTOR	APPL-NO	APPL-DATE
JP2000277843A	N/A	1999JP-0077091	March 23, 1999

INT-CL (IPC): G02B006/42, H01S005/022

ABSTRACTED-PUB-NO: JP2000277843A

BASIC-ABSTRACT:

NOVELTY - Base (130) with welding metal (132) provided integrally, mounts the semiconductor laser element (110) which has high heat conductivity. A lens holder (121) made of material similar to welding metal and with same thermal expansion coefficient, along with lens optical system (120) is mounted to the welding metal.

DETAILED DESCRIPTION - An INDEPENDENT CLAIM is also included for the manufacturing method of semiconductor laser module.

USE - In manufacture of semiconductor laser module integrated with semiconductor laser element used in optical fiber communication system.

ADVANTAGE - Optical axis slippage of semiconductor laser element and lens optical system due to thermal expansion change of base by heat generation of semiconductor laser element, lens holder, etc is eliminated by making the base and lens holder with similar material having same thermal expansion coefficient and hence reliability opposing to heat cycle is improved. Semiconductor laser module required for high optical power is produced.

DESCRIPTION OF DRAWING(S) - The figure shows the perspective diagram of the assembly process showing the manufacturing method of semiconductor laser module.

Semiconductor laser element 110

Laser optical system 120

Lens holder 121

Base 130

Welding metal 132

CHOSEN-DRAWING: Dwg.4/8

TITLE-TERMS: SEMICONDUCTOR LASER MODULE OPTICAL COMMUNICATE MOUNT
LENS HOLD
LENS OPTICAL SYSTEM WELD METAL BASE MADE SIMILAR MATERIAL WELD
METAL THERMAL EXPAND CO EFFICIENCY

DERWENT-CLASS: P81 V07 V08

EPI-CODES: V07-G02; V07-G10C; V08-A04A; V08-A08;

SECONDARY-ACC-NO:

Non-CPI Secondary Accession Numbers: N2001-217416

(11)特許出願公開番号
特開2000-277843
(P2000-277843A)

(43)公開日 平成12年10月6日(2000.10.6)

(51) Int. Cl. ⁷	識別記号	F I	ページ* (参考)
H 0 1 S 5/022		H 0 1 S 3/18	6 1 2 2 H 0 3 7
G 0 2 B 6/42		G 0 2 B 6/42	5 F 0 7 3

審査請求 有 請求項の数10 OL (全 9 頁)

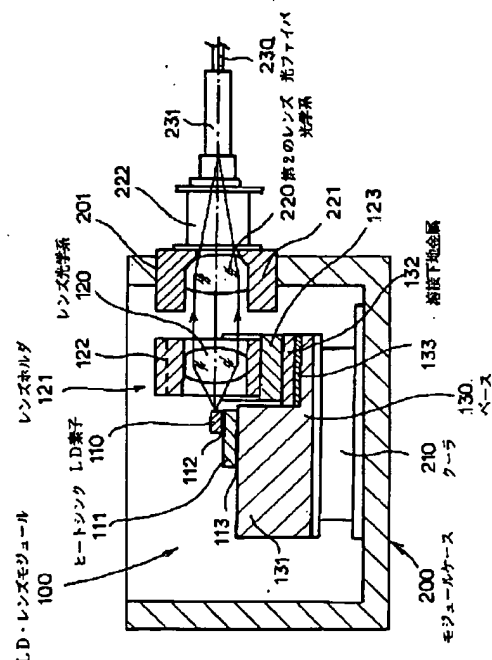
(21)出願番号	特願平11-77091	(71)出願人	000004237 日本電気株式会社 東京都港区芝五丁目7番1号
(22)出願日	平成11年3月23日(1999.3.23)	(72)発明者	吉野 隆 東京都港区芝五丁目7番1号 日本電気株式会社内
		(74)代理人	100081433 弁理士 鈴木 章夫
		Fターム(参考)	2H037 AA01 BA03 DA03 DA04 DA05 DA06 DA35 DA38 5F073 AB27 AB28 BA02 DA35 FA08 FA15 FA22 FA25

(54) 【発明の名称】 半導体レーザモジュールとその製造方法

(57) 【要約】

【課題】 LD素子を搭載するベースに対してレンズ光学系のレンズホルダの溶接による取り付けを実現するとともに、温度サイクルに対する信頼性を高めた半導体レーザーモジュールとその製造方法を提供する。

【解決手段】 LD素子110を搭載するベース130を熱伝導率の高い材料で構成するとともに、その一部には溶解性の良い溶接下地金属132を一体に設けておき、LD素子110に光結合されるレンズ光学系120は前記溶接下地金属132と熱膨張係数がほぼ等しい材料からなるレンズホルダ121（レンズ鏡筒122、レンズ固定金具123）により溶接下地金属132に溶接する。LD素子110での発熱をベース130を通して速やかに放熱することが可能であり、またLD素子110の発熱によるベース130及びレンズホルダ121の熱膨張変化に伴うLD素子110とレンズ光学系120との光軸ずれを解消し、温度サイクルに対する信頼性を改善することが可能となる。



【特許請求の範囲】

【請求項1】 ベース上に半導体レーザ素子とレンズ光学系とを搭載した半導体レーザモジュールにおいて、前記ベースは熱伝導率の高い材料で構成されるとともに、その一部には溶接性の良い溶接下地金属が一体に設けられ、前記レンズ光学系は前記溶接下地金属と熱膨張係数がほぼ等しい材料からなるレンズホルダにより前記溶接下地金属に溶接されていることを特徴とする半導体レーザモジュール。

【請求項2】 前記ベースは銅タングステン(CuW)であることを特徴とする請求項1に記載の半導体レーザモジュール。

【請求項3】 前記溶接下地金属は、前記ベースの熱膨張係数に近い熱膨張係数の材料で構成されることを特徴とする請求項1または2に記載の半導体レーザモジュール。

【請求項4】 前記レンズホルダは、レンズを保持したレンズ鏡筒と、前記レンズ鏡筒を保持するレンズ固定金具とで構成され、少なくとも前記レンズ固定金具は前記溶接下地金属と同一の材料で構成される請求項1ないし3のいずれかに記載の半導体レーザモジュール。

【請求項5】 前記溶接下地金属及びレンズ固定金具はステンレス鋼(SUS430)である請求項4に記載の半導体レーザモジュール。

【請求項6】 前記溶接はレーザ溶接であることを特徴とする請求項1ないし5のいずれかに記載の半導体レーザモジュール。

【請求項7】 請求項1ないし6に記載の半導体レーザモジュールが、光ファイバに対して光結合される第2のレンズ光学系を備えたモジュールケース内に内蔵され、前記半導体レーザモジュールのレンズ光学系と前記モジュールケースに設けられた第2のレンズ光学系とが光結合されることを特徴とする半導体レーザモジュール。

【請求項8】 熱伝導率の高い材料で構成されるベースの一部にレーザ溶接が可能な溶接下地金属を一体に設ける工程と、前記ベースの他の部分に半導体レーザ素子を搭載する工程と、前記半導体レーザを発光させて前記半導体レーザ素子から出射されるレーザ光に対してレンズ光学系を光軸合わせしながら前記レンズ光学系のレンズホルダを前記溶接下地金属上にレーザ溶接する工程を含み、前記レンズホルダと前記溶接下地金属にそれぞれの熱膨張率がほぼ等しい材料を用いることを特徴とする半導体レーザモジュールの製造方法。

【請求項9】 前記レンズ光学系は、レンズを保持するレンズ鏡筒と、前記レンズ鏡筒を保持するレンズ固定金具とで構成され、前記レンズ固定金具をレーザ溶接した後、前記レンズ固定金具に対して前記レンズ鏡筒をレーザ溶接する工程を含む請求項8に記載の半導体レーザモジュールの製造方法。

【請求項10】 前記レーザ溶接はYAG溶接であるこ

とを特徴とする請求項8または9に記載の半導体レーザモジュールの製造方法。

【発明の詳細な説明】

【0001】

【発明の属する技術分野】本発明は半導体レーザ素子(以下、LD素子と称する)とレンズ光学系とを一体化した半導体レーザモジュールに関し、特に高出力のLD素子を搭載した半導体レーザモジュールとその製造方法に関する。

【0002】

【従来の技術】半導体レーザモジュールは光ファイバ通信システムで利用されており、LD素子で発光したレーザ光をレンズ光学系により光ファイバに光結合し、光ファイバを伝送する構成となっている。そのため、この種の半導体レーザモジュールは、LD素子の発光光軸とレンズ光学系の光軸とを一致させた状態で、金属製のベース上にLD素子とレンズ光学系を搭載した構成がとられている。図8は従来の半導体レーザモジュールの断面構成図であり、LD素子110は窒化アルミニウム(AlN)で構成されたヒートシンク111に搭載され、かつこのヒートシンク111を介してコバー(Kovar)で構成されたベース130'上に固着されている。また、前記LD素子110に対向する位置の前記ベース130'上には、鋼材で構成されたレンズ鏡筒122とレンズ固定金具123からなるレンズホルダ121に組み立てられたレンズ光学系120が溶接により一体に取り付けられている。そして、前記構成のモジュール100'は、光ファイバ230に光学結合している第2のレンズ光学系220を備えるモジュールケース200内に内装され、このモジュールケース200内においてペルチェ素子等のクーラ(冷却装置)210上に搭載されて組み立てられる。なお、この組み立て状態では、前記レンズ光学系120は第2のレンズ光学系220に光結合され、前記LD素子110の発光光を前記レンズ光学系120、第2のレンズ光学系220を介して光ファイバ230に導入させている。

【0003】このような半導体レーザモジュールの組み立てにおいて、LD素子110とレンズ光学系120の光軸を一致させる技術として、先ずLD素子110をベース130'上に搭載した上で、LD素子110を発光動作させ、このLD素子110から出射されるレーザ光を基準にしてレンズ光学系120の光軸が一致するように位置決めを行い、しかる上でレンズ光学系120のレンズホルダ121をベース130'に溶接する手法がとられている。ここで、前記半導体レーザモジュールでは、前記ベース130'の材料として前記したようにコバーが用いられている。これは、前記したようにLD素子110に対してレンズ光学系120の光軸位置合わせを行いながらレンズホルダ121をベース130'に固定しているために、作業性の良い溶接YAGレーザを用

いた溶接が行われているためであり、このYAG溶接が可能な金属材料としてコパーが選択されている。因みに、レンズホルダ121をベース130'に対してろう付けする技術では、レンズホルダ121を高精度に固定することが困難である。

【0004】ところで、近年における光ファイバ通信システムでは、光伝送路を構成するための光ファイバ内を伝送する光信号を光ファイバ増幅器によって増幅する技術が提案されている。この光増幅器は、希土類元素であるエルビウムを添加した光ファイバ増幅器（以下、EDFAと称する）として構成され、このEDFAに信号光を励起するための高出力の励起光を供給する。この励起光を供給する励起用半導体レーザモジュールとして前記した構成の半導体レーザモジュールが利用されているが、所要の高光出力を得るために、LD素子に大電流を供給する必要がある、そのためLD素子での発熱量も顕著なものとなる。従来では、LD素子で発生した熱の放熱効果を高めるために、図8に示したように、LD素子110を搭載したベース130'をクーラ210を介してモジュールケース200に内装しており、LD素子110で発生した熱は、ヒートシンク111を介してベース130'に伝達され、さらにベース130'の下側に配置されているクーラ210によって冷却することが可能とされている。

【0005】しかしながら、前記したように、ベース130'の材料としてコパーを用いている従来の半導体レーザモジュールでは、コパーの熱伝導率が17W/mKと極めて低いために、EDFA用の励起用半導体レーザモジュールとして、例えば、 $0.5A \times 2V = 1W$ で駆動したときに、要求される冷却特性（ $T_c = 65^\circ C$ にて $\Delta T = 40K$ ）を満足することができない。そこで、半導体モジュールのベース130'の金属材料として、熱伝導率が（ $\sim 200W/mK$ ）とコパーに比較して格段に高い銅タングステン（CuW）を用いることが行われている。例えば、特開平7-140362号公報にはベースとして銅タングステンやシリコンカーバイトを用いることで、LD素子の放熱特性を改善し、高出力動作が得られることが記載されている。

【0006】また、ベースに銅タングステンを用いると、銅タングstenはYAG溶接によるレンズ固定金具の取り付けが不可能であるため、前記従来の半導体レーザモジュールのように、ベースに先にLD素子を固着しておき、LD素子の光軸に対してレンズ光学系を光軸合わせしながらレンズ光学系のレンズホルダをベースに取り付ける構造の半導体モジュールへの適用は困難である。このような問題に対しては、レンズホルダを取り付けるベース130'の表面に、図8に鎖線で示すように、予めYAG溶接が可能な金属、例えばコパーを溶接下地金属132'としてろう付け等によって一体化しておき、レンズホルダ121をこの溶接下地金属132'

にYAG溶接することが考えられる。このようにYAG溶接を可能とするために、構成部品の一部にコパーを使用する技術としては、例えば、特開平9-138329号公報に記載の技術がある。

【0007】

【発明が解決しようとする課題】しかしながら、レンズホルダ121をベース130'に溶接するための溶接下地金属132'としてコパーを用いた場合には、レンズホルダ121を構成しているレンズ鏡筒122の鋼材（SF20T）の熱膨張係数（ $11 \times 10^{-6}/^\circ C$ ）や、レンズ固定金具123のステンレス鋼（SUS304）の熱膨張係数（ $18 \times 10^{-6}/^\circ C$ ）に対して溶接下地金属132'としてのコパーの熱膨張係数（ $5.3 \times 10^{-6}/^\circ C$ ）に比較的大きな差があるため、LD素子110で発生した熱によってレンズ固定金具123及びレンズ鏡筒122と溶接下地金属132'との間に熱ストレスが生じ、この熱ストレスによってベース130'に対するレンズホルダ121の取り付け位置が変動され、LD素子110とレンズ光学系120との光軸にずれが生じるおそれがある。また、ベース130'の銅タングステンの熱膨張係数（ $8.5 \times 10^{-6}/^\circ C$ ）と、溶接下地金属132'のコパーとの熱膨張係数の差によって溶接下地金属132'が変形され、その結果レンズホルダ121の取り付け位置が変動されることもある。このような、熱膨張係数の差に伴う光軸ずれは、前記したEDFAの励起用半導体レーザモジュールとして構成したときには、光学結合設計の余裕度を越えて無視できないものとなり、結果として半導体レーザモジュールにおける温度サイクルの信頼性の低下が生じることになる。

【0008】本発明の目的は、ベースに搭載するレンズ光学系のレンズホルダの溶接による取り付けを実現するとともに、温度サイクル等の熱的環境試験に対する信頼性を高めた半導体レーザモジュールとその製造方法を提供するものである。

【0009】

【課題を解決するための手段】本発明の半導体レーザモジュールは、LD素子を搭載するベースは熱伝導率の高い材料で構成されるとともに、その一部には溶接性の良い溶接下地金属が一体に設けられ、前記ベースに搭載されるレンズ光学系は前記溶接下地金属と熱膨張係数がほぼ等しい材料からなるレンズホルダにより前記溶接下地金属に溶接されていることを特徴とする。ここで、前記ベースは銅タングステン（CuW）で構成される。また、前記溶接下地金属は、前記ベースの熱膨張係数に近い熱膨張係数の材料で構成される。さらに、前記レンズホルダは、レンズを保持したレンズ鏡筒と、前記レンズ鏡筒を保持するレンズ固定金具とで構成され、少なくとも前記レンズ固定金具は前記溶接下地金属と同一の材料で構成されることが好ましい。この場合、前記溶接下地金属及びレンズ固定金具はステンレス鋼（SUS43

0)で構成することが好ましい。また、本発明の半導体レーザモジュールは、光ファイバに対して光結合される第2のレンズ光学系を備えたモジュールケース内に内蔵され、半導体レーザモジュールのレンズ光学系と前記モジュールケースに設けられた第2のレンズ光学系とが光結合される構成であることが好ましい。

【0010】本発明の半導体レーザモジュールの製造方法は、熱伝導率の高い材料で構成されるベースの一部にレーザ溶接が可能な溶接下地金属を一体に設ける工程と、前記ベースの他の部分に半導体レーザ素子を搭載する工程と、前記半導体レーザを発光させて前記半導体レーザ素子から出射されるレーザ光に対してレンズ光学系を光軸合わせしながら前記レンズ光学系のレンズホルダを前記溶接下地金属上にレーザ溶接する工程を含み、前記レンズホルダと前記溶接下地金属にそれぞれの熱膨張率がほぼ等しい材料を用いることを特徴とする。前記レンズ光学系は、レンズを保持するレンズ鏡筒と、前記レンズ鏡筒を保持するレンズ固定金具とで構成され、前記レンズ固定金具をレーザ溶接した後に、前記レンズ固定金具に対して前記レンズ鏡筒をレーザ溶接することが好ましい。

【0011】本発明の半導体レーザモジュールでは、ベースに溶接下地金属を設けることにより、ベースとして熱伝導率の高い材料を選択したときに、ベースに対するレンズホルダの溶接が困難な場合においても、レンズホルダを溶接下地金属に対して溶接することで、ベースへのレンズホルダの取り付けが可能となる。また、レンズホルダとして、溶接下地金属と熱膨張係数がほぼ等しい材料を用いることで、LD素子の発熱によってもLD素子とレンズ光学系との光軸ずれを抑制することが可能となる。さらに、溶接下地金属をベースの熱膨張係数に近い熱膨張係数の材料を用いることで、光軸ずれをさらに抑制することが可能となる。

【0012】なお、本発明に近い技術として、特開平8-254723号公報には、銅タングステンで構成した光学ベースの穴に、ステンレス鋼やコパー等の溶接性の良い材料で形成した円筒状部材を取り付けておき、そこにレンズ固定金具を溶接する技術が記載されている。このため、ベース側に取り付ける材料としてステンレス鋼を用いる点で本発明と共通するが、この公報の技術は、ステンレス鋼は円筒状部材として構成されて光学ベースの穴内に挿入する構成である。そのため、円筒状部材が温度サイクルによって熱膨張した場合でも中心軸に対して対称に変形されるため、円筒状部材で保持している光ファイバの光軸ずれに与える影響はない。しかしながら、本発明のような円筒状部材をしていない溶接下地金属に単にステンレス鋼を用いる場合には、円筒状部材のような中心軸に対する対称性が得られないため、レンズ光学系の光軸ずれを防止することは不可能である。また、前記公報ではレンズホルダをレンズ固定金具と熱膨

張係数がほぼ等しい材料で構成することについても記載はない。

【0013】

【発明の実施の形態】次に、本発明の実施形態を図面を参照して説明する。図1は本発明の半導体レーザモジュールの一部を分解した斜視図、図2及び図3はその組立状態の平面図と断面図である。半導体レーザモジュール1は、LD素子110とレンズ光学系120を一体的に構成した狭義の半導体レーザモジュール100と、前記半導体レーザモジュール100を内装するモジュールケース200とで構成される。ここで、狭義の半導体レーザモジュール100のことをここではLD・レンズモジュールと称する。前記LD・レンズモジュール100は銅タングステン(CuW)からなるベース130に前記LD素子110とレンズ光学系120を取り付けており、前記LD素子110は、窒化アルミニウム(AlN)からなるヒートシンク111上に金属ろう材112によってろう付けされ、さらに、前記ヒートシンク111は前記ベース130の上面に突出形成された台部131の上面に金属ろう材113によってろう付けされている。また、前記ベース130の前記台部131の上面の他の箇所には回路基板140が搭載されており、前記LD素子110は前記回路基板140に金属細線141によりワイヤボンディングされ、前記回路基板140を介して給電が行われるようになっている。

【0014】一方、前記LD素子110に対向する位置の前記ベース130の上面には、ステンレス鋼鉄(SUS430)からなる平板状の溶接下地金属132がAg-Cuろう材133等によるろう付けにより一体化されている。そして、この溶接下地金属132上に前記レンズ光学系120のレンズホルダ121が固定されている。前記レンズホルダ121はレンズ鏡筒122とレンズ固定金具123とで構成されており、前記レンズ光学系120を構成する1枚以上のレンズは外形形状が矩形に近い形をした鋼材(SF20T)からなる前記レンズ鏡筒122内に構成されており、このレンズ鏡筒122は上向きコ字状をしたステンレス鋼(SUS430)からなる前記レンズ固定金具123に、YAG溶接により固定されている。また、前記レンズ固定金具123は前記溶接下地金属132の上面にYAG溶接により固定されている。図2の黒丸で示す箇所がYAG溶接の箇所である。なお、前記レンズ光学系120は、前記LD素子110の光軸と一致する光軸位置で、かつレンズ光学系120の焦点位置に前記LD素子110の発光面が位置するように位置決めされることは言うまでもない。

【0015】このような構成のLD・レンズモジュール100は、前記モジュールケース200内に内装される。前記モジュールケース200は金属材料によって箱型に形成されており、その内底面にはペルチェ素子で構成されるクーラ210が配設されており、前記LD・レン

ズモジュール100のベース130は前記クーラ210上に搭載される。また、前記モジュールケース200の一側面には、円形の開口201が開けられており、この開口201内には第2のレンズ光学系220が固定されている。前記第2のレンズ光学系220は、前記LD・レンズモジュール100のレンズ固定金具123と同様なステンレス鋼からなるレンズ鏡筒221により前記開口201内に挿入され、かつ半田材等により固定されている。また、前記レンズ鏡筒221には光ファイバ230の一端部に設けられたピグテール231を固定するための円筒状のホルダ222が一体に設けられており、前記光ファイバ230のピグテール231は前記第2のレンズ光学系220に対して光軸合わせした状態で前記ホルダ222にYAG溶接により固定されている。なお、前記光ファイバ230はその一端部の端面が前記第2のレンズ光学系220の焦点位置に位置決めされていることは言うまでもない。また、この実施形態では前記モジュールケース200には、図外の電源系の回路に接続されるリード端子240が配設されており、このリード端子240が前記モジュールケース200の内側に延長される部位には前記LD・レンズモジュール100の回路基板140に金属細線241でワイヤボンディングされている。

【0016】以上のように構成された半導体レーザモジュールのうち、前記LD・レンズモジュール100の組み立て方法を図4～図6を参照して説明する。先ず、図4において、予備工程として、銅タングステンで構成されるベース130の上面の一部に、ステンレス鋼(SUS430)からなる溶接下地金属132をAg-Cuろう材133を用いた貼り合わせにより一体化しておく。また、搭載するLD素子110をヒートシンク111にAu-Sn溶ダ(112)により溶ダ止めしておく。しかる上で、前記ベース130を作業用のステージ(図示せず)に固定し、かつ前記LD素子110を搭載した前記ヒートシンク111をアクチュエータA1で把持してベース130の台部131の上面にAu-Sn溶ダ113により溶ダ止めする。このときには、例えば、前記台部131の上面に形成した位置決め線等を利用して、あるいはヒートシンク111を把持するアクチュエータA1の機械的な位置決めによりLD素子110及びヒートシンク111の平面XY方向の位置を設定することで、ステージ上に載置されているベース130に対しての位置決めが行われる。なお、ここでX方向とは前記LD素子110の光軸方向であり、Y方向とはX方向に平面上で直交する方向である。

【0017】次いで、図5のように、前記台部131に搭載したLD素子110を、前記台部131の上面に予め搭載されている回路基板140の導電部に対して金属細線141によりワイヤボンディングし、電気的に接続する。しかる上で、前記ベース130に一体化されてい

る前記溶接下地金属132上に上向きコ字状のレンズ固定金具123を載置し、さらにレンズ固定金具123の両側壁間にレンズ鏡筒122を配置する。そして、前記レンズ鏡筒122の上面の突部124をアクチュエータA2で保持して前記レンズ鏡筒122及びレンズ固定金具123を一体的に前記溶接下地金属132の上面上で平面Y方向に移動可能とする状態に設定する。また、前記ベース130及び回路基板140に対して図外の給電部に接続されているプローブPを接触し、前記LD素子110に給電を行ってLD素子110を発光させる。そして、前記レンズ光学系120の前記LD素子110とは反対側の光軸位置においてレンズ光学系120及び第2のレンズ光学系220を透過して集光された光を測定用光ファイバFを通して検出し、かつ光検出器PDで測光を行い、その測光値が最大となるように前記レンズ光学系120の光軸合わせを行う。ここでは、アクチュエータA2により平面Y方向にレンズ鏡筒122とレンズ固定金具123を一体的に移動してLD素子110に対するレンズ光学系120の光軸合わせを行なう。そして、その光軸合わせされた位置において、同図に黒丸X1で示すように、レンズ固定金具と溶接下地金属との境界の複数箇所にYAGレーザ装置YLからYAGレーザを照射し、レンズ固定金具123を溶接下地金属132にYAG溶接する。このとき、レンズ固定金具123と溶接下地金属132は同じステンレス鋼であるため、YAG溶接は可能である。

【0018】しかる後、図6のように、溶接下地金属132上に固定されたレンズ固定金具123内において、レンズ鏡筒122のみがアクチュエータA2によって平面X方向とZ方向(上下方向)に移動可能な状態として、レンズ鏡筒122をLD素子110に対して微細な光軸合わせを行なう。この場合においても、プローブPからの給電によりLD素子110を発光させ、前記光ファイバF及び光検出器PDを利用してレンズ光学系120及び第2のレンズ光学系220を透過して集光させた測光値が最大となる位置を設定する。そして、この光軸合わせした位置において、同図に黒丸X2で示すように、レンズ鏡筒122とレンズ固定金具123との境界の複数箇所にYAGレーザ装置YLからYAGレーザを照射し、レンズ鏡筒122をレンズ固定金具123にYAG溶接する。このとき、レンズ鏡筒122は鋼材であるため、レンズ固定金具123とのYAG溶接は可能である。これにより、LD素子110に対して光軸合わせしたレンズ光学系120をベース130に取り付けることが完了される。

【0019】なお、以上のように組み立てられたLD・レンズモジュール100は、前記モジュールケース200内に予め配設してあるクーラ210上に搭載し、固定する。その際には、前記LD・レンズモジュール100のLD素子110及びレンズ光学系120を前記モジュ

ールケース200に設けられている第2のレンズ光学系220に対して光軸合わせを行う。この際の光軸合わせでは、第2のレンズ光学系220に接続される光ファイバ230を通して測光を行なうことにより、前記と同様に適正な光軸合わせが可能になる。

【0020】以上の製造工程によれば、熱伝導率が $\sim 200\text{W/mK}$ と、コパーよりも大きい一方で、YAG溶接による固定が困難な銅タングステンでLD・レンズモジュール100のベース130を形成しても、レンズホルダ121、すなわちレンズ固定金具123をベース130に固定する箇所はYAG溶接が可能なステンレス鋼からなる溶接下地金属132が存在しているため、両者のYAG溶接が可能となる。もちろん、レンズ鏡筒122をレンズ固定金具123に固定する際にもYAG溶接が可能となる。そのため、前記した組み立て時に、LD素子110を発光させ、その発光光を利用してレンズ光学系120に対する光軸合わせを行いながらのレンズ鏡筒122及びレンズ固定金具123の位置決め、さらにレンズ固定金具123及びレンズ鏡筒122のYAG溶接による固定が可能となり、高精度に光軸合わせされたLD・レンズモジュール100の組み立てが可能となる。因みに、レンズ固定金具123やレンズ鏡筒122をろう材や接着剤等によりベース130に固定したときには、位置合わせ後のろう材や接着剤の固化時に位置ずれが生じ易く、高精度の位置決め固定は困難である。

【0021】したがって、このようにして組み立てられた半導体レーザモジュール1では、LD素子110が発光したときに生じる熱を、熱伝導率の大きい銅タングステンからなるベース130によって速やかに伝熱し、下面に設けたクーラ210により冷却することが可能となり、EDFA用の励起用半導体レーザモジュールとして構成した場合に、LD素子110の光出力が増大された場合でも所要の冷却特性を満たすことが可能となる。

【0022】また、一方で、図7(a)に前記LD・レンズモジュール100を構成する各部の材料とその熱膨張係数を示すように、ベース130の銅タングステンの熱膨張係数($8.5 \times 10^{-6}/^{\circ}\text{C}$)に対し、溶接下地金属132及びレンズ固定金具123のステンレス鋼(SUS430)の熱膨張係数は($11 \times 10^{-6}/^{\circ}\text{C}$)であり、またレンズ鏡筒122の鋼材(SF20T)の熱膨張係数は($11 \times 10^{-6}/^{\circ}\text{C}$)である。このため、ベース130、溶接下地金属132、レンズ固定金具123、レンズ鏡筒122の相互間におけるそれぞれの熱膨張係数の差は($2.5 \times 10^{-6}/^{\circ}\text{C}$, 0, 0)であり、LD素子110の発熱等による熱サイクルを受けた場合でも、レンズ固定金具123及びレンズ鏡筒122に加ええられる熱ストレスは低減でき、熱ストレスによるレンズ固定金具123及びレンズ鏡筒122の変形は抑制される。これにより、熱サイクルによるLD素子110とレンズ光学系120との間の光軸のずれが実害のない程

度に抑制でき、半導体レーザモジュールの信頼性が改善される。

【0023】因みに、図8に鎖線で示したコパーの溶接下地金属132'を設けた従来の半導体レーザモジュールの場合を比較例として図7(b)に示すと、溶接下地金属132'としてのコパーの熱膨張係数は($5.3 \times 10^{-6}/^{\circ}\text{C}$)であり、レンズ固定金具123としてのステンレス鋼(SUS304)の熱膨張係数は($18 \times 10^{-6}/^{\circ}\text{C}$)であるため、ベース130'、溶接下地金属132'、レンズ固定金具123、レンズ鏡筒122の相互間におけるそれぞれの熱膨張係数の差は($3.2 \times 10^{-6}/^{\circ}\text{C}$, $12.7 \times 10^{-6}/^{\circ}\text{C}$, $7 \times 10^{-6}/^{\circ}\text{C}$)であり、LD素子110の発熱等による熱サイクルを受けた場合における、レンズ固定金具123及びレンズ鏡筒122に加ええられる熱ストレスは大きく、熱ストレスによるレンズ固定金具123及びレンズ鏡筒122の光軸ずれは顕著なものとなる。なお、この場合、レンズ固定金具123に本発明と同様なステンレス鋼(SUS430)を用いた場合でも、コパーとの熱膨張係数の差は($5.7 \times 10^{-6}/^{\circ}\text{C}$)であり、レンズ固定金具123及びレンズ鏡筒122における熱ストレスによる光軸ずれを抑制することは困難である。

【0024】なお、前記実施形態の半導体レーザモジュール1においても、LD素子110の光出力をEDFA用に高めた場合には、LD素子110による発熱の影響が大きく、LD・レンズモジュール100のレンズ光学系120と、モジュールケース200の第2のレンズ光学系220との間に多少の光軸ずれが生じることが考えられる。しかしながら、この半導体レーザモジュールでは、これらレンズ光学系120と第2のレンズ光学系220とは、図3に示すように、平行光束によって光結合しているため、レンズ光学系120と第2のレンズ光学系220との間に光軸と垂直な方向の光軸ずれが生じた場合でも、その光軸ずれによるLD素子110と光ファイバ230との間の光結合効率の低下は殆ど生じることではなく、高い光結合効率を維持することが可能である。

【0025】ここで、前記実施形態では、溶接下地金属として、ステンレス鋼(SUS430)を用いているが、溶接、特にYAG溶接のようなレーザ溶接が可能な材料で、かつベースを構成する銅タングステンと熱膨張係数が近い材料であれば、同様に適用することが可能である。また、レンズ固定金具及びレンズ鏡筒は、前記溶接下地金属と熱膨張係数が同一でなくとも、ほぼ同一であればよく、したがってこれらの部材は必ずしも同一材料で構成される必要はない。さらに、前記実施形態では、レンズ光学系の光軸合わせを容易に行うために、レンズホルダをレンズ鏡筒とレンズ固定金具とで別体に構成しているが、光軸合わせに支障がなければ、レンズホルダを1つのブロックとして構成することも可能である。この場合には、レンズホルダ全体が1つの材料で構

11

成されるため、前記実施形態よりも熱膨張係数による光軸ずれの影響をさらに小さくすることができる。

【0026】

【発明の効果】以上説明したように本発明は、LD素子を搭載するベースを熱伝導率の高い材料で構成するとともに、その一部には溶接性の良い溶接下地金属を一体に設けておき、LD素子に光結合されるレンズ光学系は前記溶接下地金属と熱膨張係数がほぼ等しい材料からなるレンズホルダにより溶接下地金属に溶接した構成とすることで、LD素子での発熱をベースを通して速やかに放熱することが可能であり、またその一方でLD素子の発熱によるベース及びレンズホルダ等の熱膨張変化に伴うLD素子とレンズ光学系との光軸ずれを解消し、温度サイクルに対する信頼性を改善することが可能となる。これにより、本発明の半導体レーザモジュールを高光出力が要求されるEDFA用の励起用半導体レーザモジュールとして構成することが可能となる。

【図面の簡単な説明】

【図1】本発明の半導体レーザモジュールの実施形態の一部を分解した斜視図である。

【図2】図1の半導体レーザモジュールの組み立て状態の平面図である。

【図3】図2のAA線に沿う断面図である。

【図4】本発明の半導体レーザモジュールの製造方法を示す組立工程のその1の斜視図である。

12

【図5】本発明の半導体レーザモジュールの製造方法を示す組立工程のその2の斜視図である。

【図6】本発明の半導体レーザモジュールの製造方法を示す組立工程のその3の斜視図である。

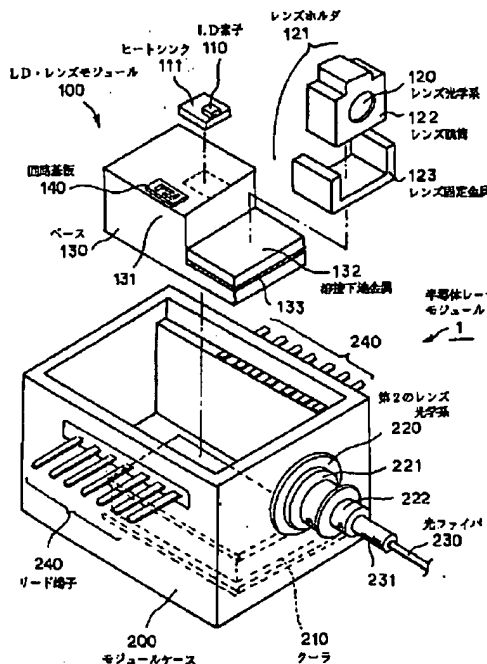
【図7】本発明と従来のLD・レンズモジュールの各部の熱膨張係数を比較して示す図である。

【図8】従来の半導体レーザモジュールの断面構成図である。

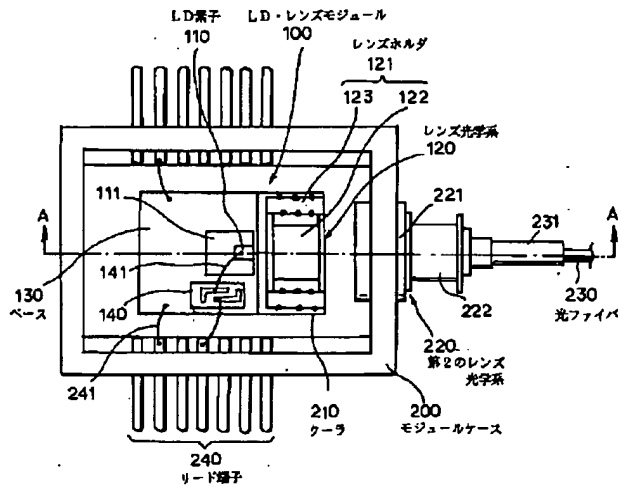
【符号の説明】

- | | |
|----|-----------------|
| 10 | 1 半導体レーザモジュール |
| | 100 LD・レンズモジュール |
| | 110 LD素子 |
| | 111 ヒートシンク |
| | 120 レンズ光学系 |
| | 121 レンズホルダ |
| | 122 レンズ鏡筒 |
| | 123 レンズ固定金具 |
| | 130 ベース |
| | 132 溶接下地金属 |
| 20 | 140 回路基板 |
| | 200 モジュールケース |
| | 210 クーラ（パルチエ素子） |
| | 220 第2のレンズ光学系 |
| | 230 光ファイバ |
| | 240 コネクタ端子 |

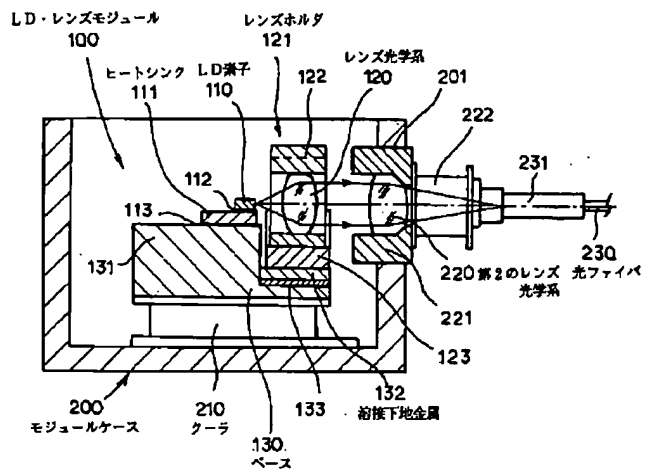
【図1】



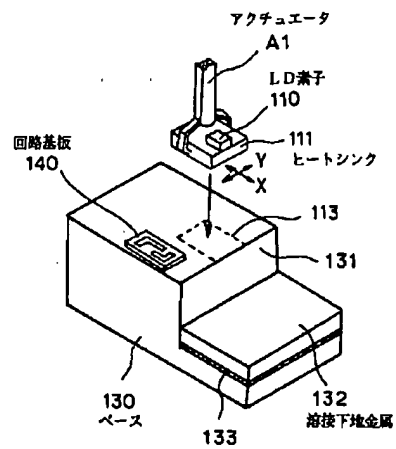
【図2】



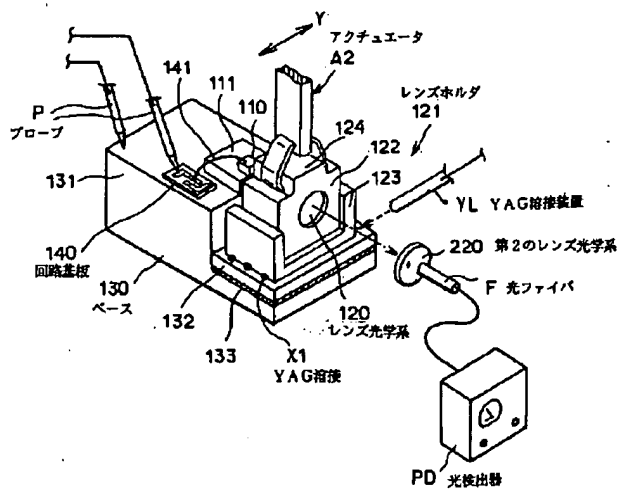
【図3】



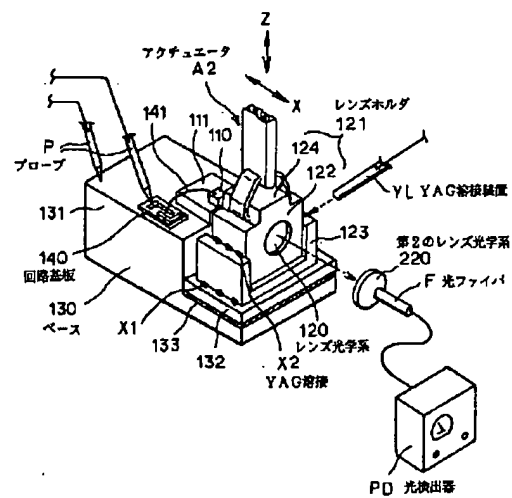
【図4】



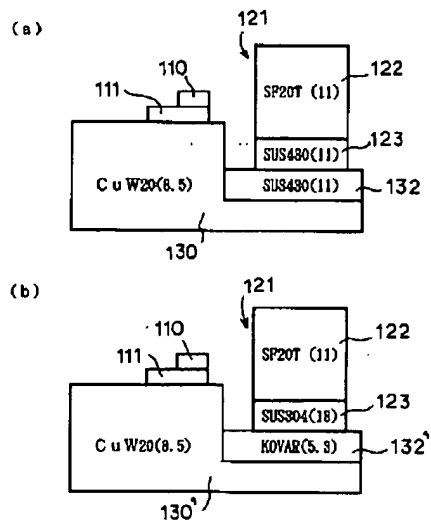
【図5】



【図6】



【図7】



() 内の値は熱膨張係数 ($\times 10^{-6}/^{\circ}\text{C}$)

【図8】

